

时刻 t_2 时的结温增量:

$$\Delta T_{j2} = P_1 \cdot \sum_{v=1}^n R_{thv} \left[1 - \exp \left(-t_2 / \tau_{thv} \right) \right] + (P_2 - P_1) \cdot \sum_{v=1}^n R_{thv} \left[1 - \exp \left(- (t_2 - t_1) / \tau_{thv} \right) \right] \quad (3.14)$$

时刻 t_m 时的结温增量:

$$\Delta T_j(t_m) = \sum_{\mu=1}^m (P_\mu - P_{\mu-1}) \cdot \sum_{v=1}^n R_{thv} \left[1 - \exp \left(- (t_m - t_{\mu-1}) / \tau_{thv} \right) \right] \quad (3.15)$$

以上公式中，采用恒定的壳温作为参考点。

3.2.2.3 脉冲调制时的结温

处于周期性脉冲功耗负载下的平均和最大结温，可由参数表中所给出的晶体管和二极管的用于周期性脉冲运行的 Z_{thjc} 曲线来计算。

图 3.11 以 SKM100GB123D 为例，显示了模块中 IGBT 和二极管的相应曲线和在脉冲运行条件下电流和结温的曲线。

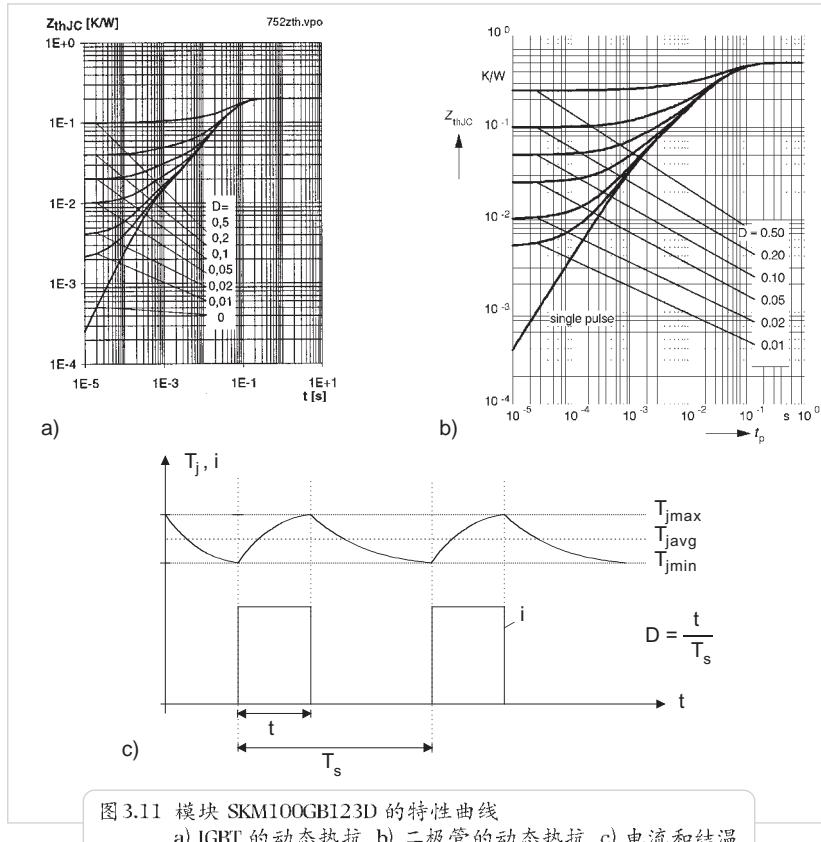


图 3.11 模块 SKM100GB123D 的特性曲线
a) IGBT 的动态热抗 b) 二极管的动态热抗 c) 电流和结温

平均结温 T_{javg} 可以由静态热阻 R_{thjc} 与平均总功耗 P_{totavg} 相乘而得到。平均总功耗又可通过对一个周期 T_s 内每一个脉冲的能耗进行平均而得到。

$$P_{totavg} = f_s * (E_{on} + E_{off} + E_{fw})$$

$$T_{javg} = T_c + P_{totavg} * R_{thjc}$$

最大结温 T_{jmax} 则可由脉冲运行时的热抗值 Z_{thjc} 与最大功耗 P_{totmax} 相乘而得到。最大功耗又可以通过对一个周期 T_s 内每一个脉冲的能耗就其开通时间 t 进行平均而得到：

$$P_{totmax} = (E_{on} + E_{off} + E_{fw})/t$$

$$T_{jmax} = T_c + P_{totmax} * Z_{thjc}$$

以 IGBT 模块 SKM100GB123D 为例：

例一： $f_s = 10 \text{ kHz}$; $T_s = 100 \mu\text{s}$; $D_T = 0.2$; $t = 20 \mu\text{s}$

$$T_c = 80^\circ\text{C}; E_{on} + E_{off} + E_{fw} = 25 \text{ mJ}$$

$$R_{thjc} = 0.2^\circ\text{C}/\text{W}, Z_{thjc} = 0.04^\circ\text{C}/\text{W} (\text{见图 3.11a})$$

结果： $P_{totavg} = 250 \text{ W}$; $P_{totmax} = 1250 \text{ W}$

$$T_{javg} = 80^\circ\text{C} + 250 \text{ W} * 0.2^\circ\text{C}/\text{W} = 130^\circ\text{C}$$

$$T_{jmax} = 80^\circ\text{C} + 1250 \text{ W} * 0.04^\circ\text{C}/\text{W} = 130^\circ\text{C}$$

例二： $f_s = 2 \text{ kHz}$; $T_s = 500 \mu\text{s}$; $D_T = 0.2$; $t = 100 \mu\text{s}$

$$T_c = 80^\circ\text{C}; E_{on} + E_{off} + E_{fw} = 25 \text{ mJ}$$

$$R_{thjc} = 0.2^\circ\text{C}/\text{W}, Z_{thjc} = 0.042^\circ\text{C}/\text{W} (\text{见图 3.11a})$$

结果： $P_{totavg} = 50 \text{ W}$; $P_{totmax} = 250 \text{ W}$

$$T_{javg} = 80^\circ\text{C} + 50 \text{ W} * 0.2^\circ\text{C}/\text{W} = 90^\circ\text{C}$$

$$T_{jmax} = 80^\circ\text{C} + 250 \text{ W} * 0.042^\circ\text{C}/\text{W} = 90.5^\circ\text{C}$$

例三： $f_s = 2 \text{ kHz}$; $T_s = 500 \mu\text{s}$; $D_T = 0.2$; $t = 100 \mu\text{s}$

$$T_c = 80^\circ\text{C}; E_{on} + E_{off} + E_{fw} = 125 \text{ mJ}$$

$$R_{thjc} = 0.2^\circ\text{C}/\text{W}, Z_{thjc} = 0.042^\circ\text{C}/\text{W} (\text{见图 3.11a})$$

结果： $P_{totavg} = 250 \text{ W}$; $P_{totmax} = 1250 \text{ W}$

$$T_{javg} = 80^\circ\text{C} + 250 \text{ W} * 0.2^\circ\text{C}/\text{W} = 130^\circ\text{C}$$

$$T_{jmax} = 80^\circ\text{C} + 1250 \text{ W} * 0.042^\circ\text{C}/\text{W} = 132.5^\circ\text{C}$$

例四： $f_s = 50 \text{ Hz}$; $T_s = 20 \text{ ms}$; $D_T = 0.5$; $t = 10 \text{ ms}$

$$T_c = 80^\circ\text{C}; E_{on} + E_{off} + E_{fw} = 5 \text{ J}$$

$$R_{thjc} = 0.2^\circ\text{C}/\text{W}, Z_{thjc} = 0.12^\circ\text{C}/\text{W} (\text{见图 3.11a})$$

结果： $P_{totavg} = 250 \text{ W}$; $P_{totmax} = 500 \text{ W}$

$$T_{javg} = 80^\circ\text{C} + 250 \text{ W} * 0.2^\circ\text{C}/\text{W} = 130^\circ\text{C}$$

$$T_{jmax} = 80^\circ\text{C} + 500 \text{ W} * 0.12^\circ\text{C}/\text{W} = 140^\circ\text{C}$$

在例一中采用了 IGBT 常用的开关频率 10kHz。由于 IGBT 在高频时的热抗较小，所以结温的平均值和最大值没有明显的不同。

在例二和例三中，开关频率降为 2kHz，但在例二中保持能耗不变，而在例三中则保持平均功耗和最大功耗不变。两个例子的计算结果显示出平均结温和最大结温有所不同。

可以简单地认为，当开关频率大于 3kHz 时，采用平均功耗与静态热阻所做出的计算已经足够精确。

例四显示了在很低的开关频率下，平均结温和最大结温有着明显的差异。

3.2.2.4 基波频率下的结温

器件的结温实际上是随着变流器输出电流的基波而变化的，但它的计算只有借助于计算机才能够有效地进行。

在计算中，先必须对每一个脉冲周期的电路和热路进行详细计算，然后才有可能对一个正弦半波进行积分，进而得到 IGBT 和续流二极管的结温。

图 3.12 显示了在 [194] 中介绍过的此类计算方法的原理方框图。

